

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

**Band:** 89 (1998)

**Heft:** 7

**Artikel:** Metalloxid : ein fast idealer Überspannungsableiter

**Autor:** Schmidt, Walter

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-902060>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Das elektrische Verhalten von Metalloxidableitern entspricht in nahezu idealer Weise den Anforderungen, die an einen Überspannungsableiter gestellt werden. In den beiden letzten Jahrzehnten wurden daher zunehmend solche Ableiter eingesetzt. Neuere Konstruktionen der Ableiter ersetzen die alte Porzellanisolation durch Polymerkunststoffe und ermöglichen einen explosions sicheren Betrieb.

# Metalloxid – ein fast idealer Überspannungsableiter

■ Walter Schmidt

Die Überspannungsableitertechnik hat sich in den letzten 25 Jahren massgeblich verändert. Die Funkenstreckenableiter (FS) mit Siliziumkarbidwiderständen wurden zunächst durch die systematische Einführung der magnetischen Bebläsung wesentlich verbessert. Seit nunmehr 18 Jahren werden zunehmend auch in Europa funkenstreckenlose Ableiter mit stark nichtlinearen Metalloxid(MO)-Widerständen auf Zinkoxid-Basis (ZnO) auf allen Spannungsebenen eingesetzt.

Ein weiterer Schritt in der Ableitertechnik war dann die in den letzten zehn Jahren eingeführte Polymer-Kunststoffisolation, die erstmals den Einsatz porzellanfreier explosions sicherer Ableiter ermöglichte. Die Kernelemente dieser funkenstreckenlosen Ableiter, die MO-Widerstände, wurden in den letzten zehn Jahren kontinuierlich verbessert. Die hervorragenden Schutzeigenschaften sind gekennzeichnet durch niedrige, im Betrieb unveränderte Schutzpegel. Die sehr hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit der MO-Widerstände ergeben in Verbindung mit neuen wirtschaftlichen Konstruktionsprinzipien einen fast idealen Überspannungsableiter.

MO-Ableiter haben sich weltweit hervorragend zum Schutz der übrigen

Betriebsmittel bewährt und die Verfügbarkeit elektrischer Energie weiter verbessert.

## Funkenstrecken(FS)- und Metalloxid(MO)-Ableiter

In Tabelle I sind zum Vergleich wesentliche Eigenschaften beider Ableiter zusammengestellt.

Ein bedeutender Nachteil des FS-Ableiters ergibt sich aus den physikalischen Eigenschaften der Funkenstrecke. Die Ansprechspannung der FS-Ableiter ist gekennzeichnet durch eine relativ grosse Streuung von etwa 15%. Der während des Ansprechens fliessende Strom erodiert zudem die Funkenstrecken des Ableiters und ist mit einem mehr oder weniger starken Spannungszusammenbruch verbunden.

Der letztgenannte Effekt und die Streuung werden durch Bild 1 beim direkten Vergleich der Überspannungsbegrenzung eines FS- und eines MO-Ableiters verdeutlicht.

Die Begrenzung der Überspannung positiver und negativer Polarität ist beim FS-Ableiter durch eine deutlich grössere Abhängigkeit von der Steilheit der Impulse und durch einen nachfolgenden Spannungszusammenbruch gekennzeichnet. Der MO-Ableiter begrenzt dagegen die Überspannungen weitestgehend unbeeinflusst von der Steilheit auf stets annähernd gleich grosse Restspannungen ohne einen nachfolgenden Spannungszusammenbruch.

Bei Überspannungen als Folge von direktem Blitzeinschlag oder rückwärtigem Überschlag mit steiler Front bietet der MO-Ableiter optimalen Schutz gegen

Adresse des Autors  
Walter Schmidt, dipl. Ing., ABB Hochspannungstechnik AG, Jurastrasse 45  
5430 Wettingen



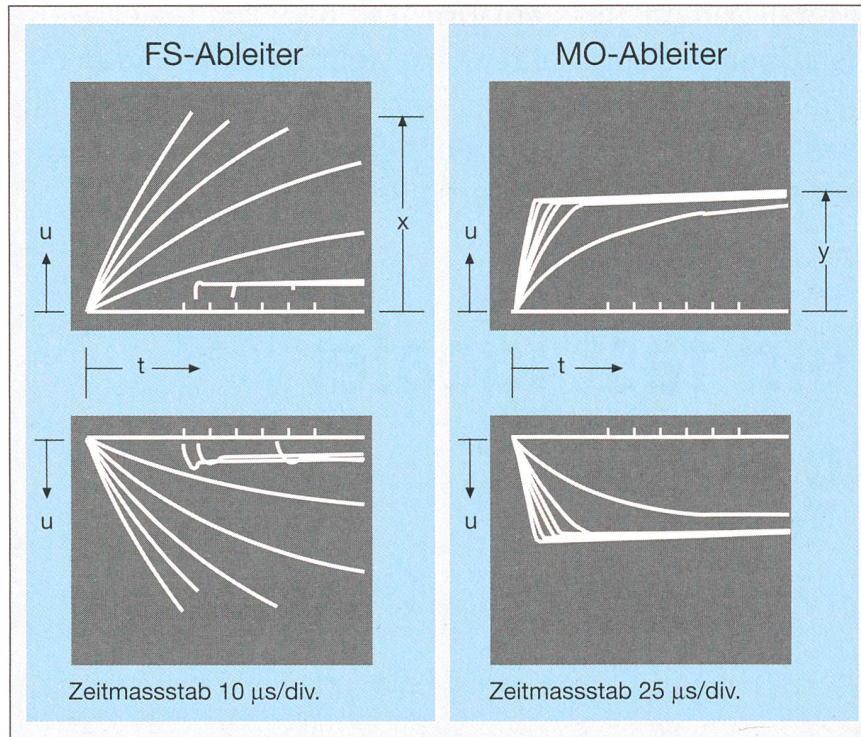


Bild 1 Prinzipielles Verhalten von FS- und MO-Ableitern

Impulsalterung zum Beispiel von modernen Trockentransformatoren und PE-Kabeln.

Alle Spannungen unterhalb des Ansprechwertes unterlaufen FS-Ableiter, womit die Gefahr reflektierter Überspannungen besteht. MO-Ableiter begrenzen hingegen, sobald der Kniebereich der Kennlinie überschritten wird (Bild 2). Speziell im Schaltspannungsbereich sind bei MO-Ableitern die Spannungsbegrenzungspegel deutlich günstiger als bei FS-Ableitern.

MO-Ableiter haben bei gleichem oder sogar verringertem Bauvolumen generell eine höhere Energieaufnahmefähigkeit als FS-Ableiter. Bei temporären betriebsfrequenten Überspannungen sind MO-Ableiter in der Lage, oberhalb der Dauerbetriebsspannung Energie aufzunehmen. Durch Parallelschaltung gleichartiger MO-Ableiter im gleichen Leitungszweig kann die Energieaufnahme praktisch bei allen Wellenformen erhöht werden. Dies sind die wichtigsten Gründe, warum heutzutage FS-Ableiter mehr und mehr durch MO-Ableiter ersetzt werden.

## Metalloxidwiderstände, der Kern moderner Ableiter

### Prinzipielles Verhalten

Metalloxid-Keramikwiderstände, die man als nichtlineare Widerstände, auch als Varistoren bezeichnet, bilden das Aktivteil aller funkenstreckenlosen Ableiter.

Das Verhalten der realen MO-Widerstände wird in Bild 2 beschrieben und mit dem eines idealen Ableiterverhaltens verglichen. Die Darstellung der Kennlinie demonstriert, dass die Entwicklung der letzten Jahre zu Metalloxiden geführt hat,

die dem idealen Ableiter bereits sehr nahe kommen.

Im Betrieb muss während der Beanspruchung mit der Dauerspannung der Höchstwert der Spannung – bei Wechselspannung ist das der Scheitelwert – immer unterhalb des Kniebereiches liegen. In diesem Bereich ist der Widerstand sehr hochohmig.

Beim Auftreten von Überspannungen geht im Bereich des Kennlinienknies der vorher hochohmige Widerstand sehr rasch vom nichtleitenden in den leitenden Zustand über. Der MO-Widerstand wird niederohmig. Bei diesem Vorgang ändert sich der elektrische Widerstand des Ableiters um etwa acht Grössenordnungen.

Die mit dem Vorgang verbundene Energieaufnahme führt zur Erwärmung des MO-Widerstandes. Der Effekt der Überspannungsbegrenzung läuft auch bei steilem Spannungsanstieg sehr rasch ab und ist voll reversibel. Beim Absinken der Spannung unter den Kniebereich wird der Widerstand wieder hochohmig und daher nahezu nichtleitend. In diesem Bereich hat der Ableiter Kondensatoreigenschaften.

Es ist keine analytisch geschlossene Formel zur Beschreibung des Strom-Spannungs-Verhaltens des MO-Ableiters bekannt. Für die Charakteristik lässt sich die empirische Funktion  $U = k \cdot I^{\alpha(U)}$  anwenden.  $k$  ist eine Konstante, während der Exponent  $\alpha$  den Grad der Nicht-

MO-Ableiter	FS-Ableiter
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kein Ansprechen, Strom fliesst entsprechend U-I-Kennlinie</li> <li>– Kein Streuungen in den Restspannungen Typisch: <math>\pm 3\%</math></li> <li>– Gutes Steilstossverhalten Beispiel: Nur ca. 10% Zunahme der Restspannung bei <math>1/3 \mu s</math> im Vergleich zu Stromstoss zu <math>8/20 \mu s</math></li> <li>– Temporäre 50-Hz-Belastung oberhalb <math>U_c</math> möglich</li> <li>– Energieaufnahmevermögen kann durch Parallelschalten von MO-Säulen erhöht werden</li> <li>– Einfacher Aktivteil</li> <li>– Alterung vernachlässigbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ansprechen, anschliessend 50-Hz-Folgestrom</li> <li>– Übliche Streuungen von Funkenstrecken, Beeinflussung durch Spannungsversteuerung möglich Streiband bis zu 15%</li> <li>– Starke Zunahme (<math>&gt;25\%</math>) der Ansprechspannung bei sehr steilen Stossspannungen</li> <li>– <math>U_{50Hz} &lt; \text{Nennspannung}</math></li> <li>– Begrenztes Energieaufnahmevermögen, --&gt;Parallelschaltung nicht wirksam</li> <li>– Spannungen unter dem Ansprechwert unterlaufen den Ableiter (Gefahr reflektierter Wellen)</li> <li>– Komplizierter Aufbau des Aktivteils: FS+Widerstand (Steuerwiderstand +Kapazität)</li> <li>– Alterung der Funkstrecken infolge Abbrand oder Perlenbildung</li> </ul>

Tabelle I Vergleich zwischen Metalloxid(MO)- und Funkenstrecken-Ableitern



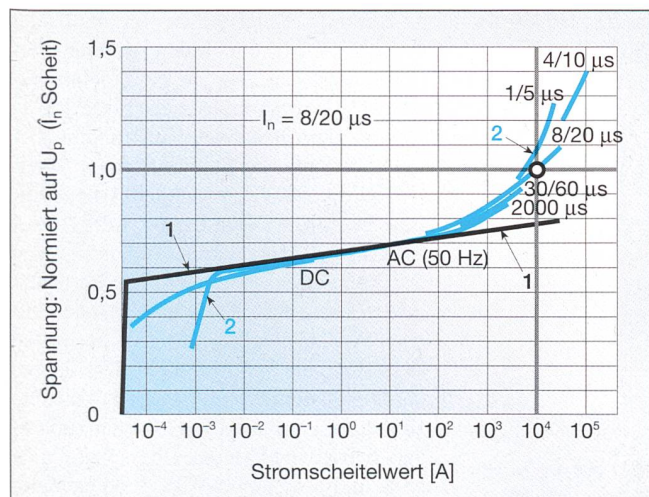


Bild 2 Strom-Spannungs-Kennlinien

1 idealer Ableiter  
2 realer MO-Ableiter

linearität repräsentiert. Für  $\alpha$  sind Werte bis zu 100 bekannt. Ein ausschliesslich rein ohmscher Widerstand hätte natürlich einen Wert 1.

### Herstellungsprozess

Der Herstellungsprozess solcher Widerstände wird in [1] detailliert beschrieben. Bild 3 zeigt schematisch die einzelnen Prozessschritte.

Als Ausgangsmaterial wird pulverförmiges, sehr feinkörniges Zinkoxid (ZnO) verwendet und in Wasser gelöst. Diesem ZnO, mit einer Partikelgrösse um 1  $\mu\text{m}$ , werden rund zehn Metalldotierelemente (Bi, Sb, Co, Mn) in Form feiner Oxidpulver zugemischt. Ihr Gewichtsanteil liegt bei 10%. Der Anteil einzelner Komponenten reicht von einigen ppm bis zu einigen Prozent. Die Reinheit und Feinheit

dieser Mischung ist von grösster Bedeutung für die Qualität der fertigen MO-Widerstände.

Die wässrige Aufschlämmung der gut gemischten Bestandteile wird in einem Sprühtrockner zu trockenem Granulat weiterverarbeitet.

Im nächsten Fertigungsschritt wird das Granulat zu scheibenförmigen Rohkörpern verpresst. Diese Presslinge werden in einem Sinterofen bei rund 1200 °C gesintert. Dabei verdichtet sich das Pulver zu einem kompakten Keramikkörper.

Die Weiterverarbeitung der Keramikblöcke zu fertigen MO-Widerständen geschieht durch Aufsprühen von gut leitfähigen Metallelektroden auf die Stirnflächen und durch Beschichten der Mantelflächen mit einem dichten Glasüberzug.

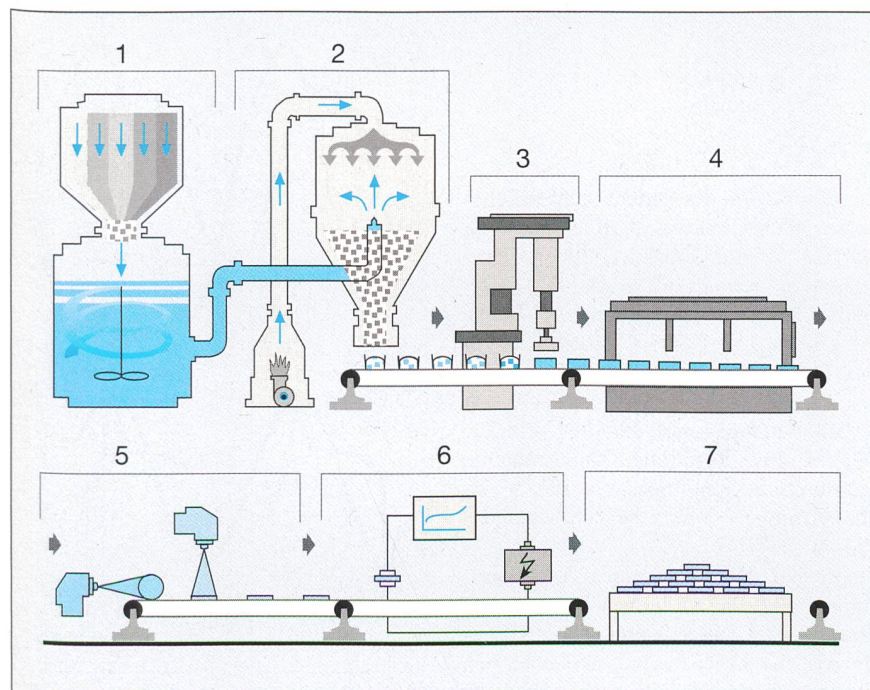


Bild 3 Schema des Herstellungsprozesses von MO-Ableitern

Den Schluss des Fertigungsprozesses bildet eine elektrische Stückprüfung. Daran anschliessend werden die MO-Widerstände mit den wichtigsten kennzeichnenden Daten (zum Beispiel der Restspannung bei Impulsstrom) und der Fertigungslos-Nummer bedruckt.

Der vorstehend nur kurz und vereinfachend dargestellte Prozess benötigt ein sehr detailliertes Wissen. Die intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der letzten 15 Jahre führten zu einem tieferen Verständnis der Varistorphysik und zu einer kontinuierlichen Prozessverbesserung bei der Fabrikation.

Die elektrischen Eigenschaften der MO-Widerstände sind direkt von der Mikrostruktur abhängig. Eine mikroskopische Untersuchung der MO-Widerstände zeigt, dass die Keramik aus einer Vielzahl von dicht gepackten ZnO-Körnern besteht. Die Grösse eines solchen Korns ist etwa 20  $\mu\text{m}$ . Der Kern des Korns besteht aus ZnO und ist elektrisch sehr gut leitend (1  $\Omega\text{cm}$ ). Die Bindungen zwischen den Körnern werden durch eine Grenzschicht von nicht mehr als 0,2  $\mu\text{m}$  Dicke gebildet.

Jedes dieser Körner bildet, verbunden mit einem anderen Korn, einen Mikrovaristor mit einer Korngrenzen-Durchbruchspannung von etwa 3,5 V. Die Mikrovaristoren innerhalb eines makroskopischen Keramikkörpers bilden ein unregelmässiges Gitter von parallel und in Reihe geschalteten Widerständen. Da an jedem einzelnen Mikrovaristor etwa 3,5 V abfallen können, bevor es zum Durchbruch kommt, wird die maximale Durchbruchspannung von der Höhe des Keramikkörpers bestimmt. Der Durchmesser des MO-Widerstandes legt dagegen den maximal zulässigen Strom des Ableiters fest.

Diese Eigenschaften erlauben es, Keramikkörper für grosse elektrische Anforderungen zu fertigen. Übliche Durchmesser für MO-Widerstände sind 30, 38, 42, 47, 62, 75, 96 und 108 mm, mit Höhen bis zu mehr als 46 mm (siehe auch Tabelle II). Eine Auswahl solcher Widerstände zeigt Bild 4.

### MO-Ableiter-Auslegung und Schutz

Die Strom-Spannungs-Kennlinie eines modernen Mittelspannungsableiters ist in Bild 5 dargestellt. Die Kennlinie zeigt ähnlich wie Bild 2 die Restspannungen in Abhängigkeit vom Strom für verschiedene Wellenformen. Die nachstehenden Ausführungen gelten sinngemäss für alle MO-Ableiter.

In der Darstellung wurden die Bezeichnungen wie in Tabelle II nach IEC



<b>Ableiter-Dauerspannung</b> Operating Voltage	$U_c$	
<b>Ableiter-Bemessungsspannung</b> Rated Voltage	$U_r$	
<b>Blitzstossstrom:</b> <b>Ableitstossstrom</b> Impulse Current	8/20 $\mu$ s	$I_B$
<b>Nennableitstossstrom</b>	8/20 $\mu$ s	$I_n$ 2,5 bis 20 kA
<b>Hochstossstrom</b> High Impulse Current	4/10 $\mu$ s	$I_{HC}$ 65 bis 100 kA

Tabelle II MO-Ableiter-Terminologie

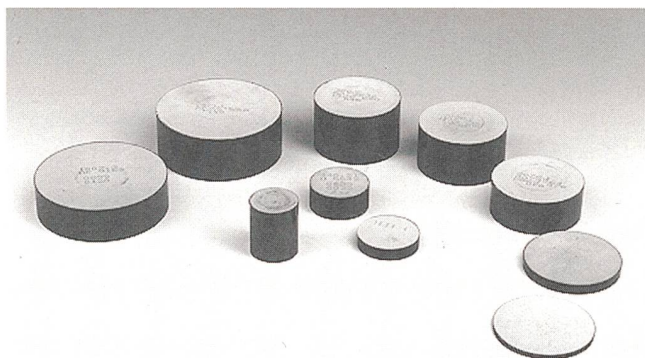


Bild 4 Metalloxidwiderstände für Hoch- und Mittelspannungsableiter

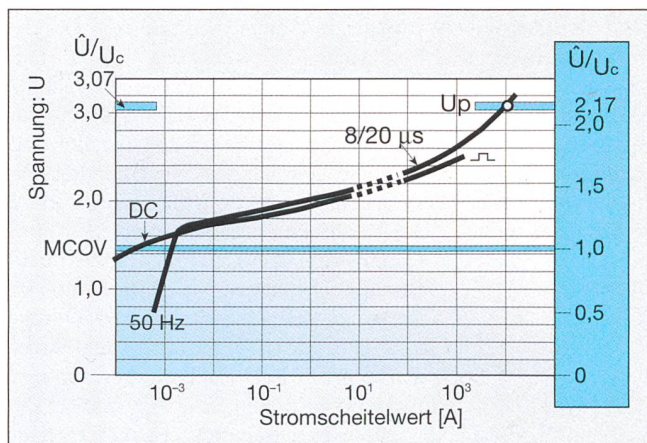


Bild 5 Schutzkennlinie eines Mittelspannungsableiters

99.4 (199 111) [2] gewählt. Die Spannungen sind dabei als «Per Unit»-Werte auf die Restspannung bei einem Nennstossstrom  $U_p$  der genormten Wellenform 8/20  $\mu$ s bezogen.

Der komplette Ableiter besteht aus einer Serienschaltung von einzelnen MO-Widerständen mit typischerweise 1 bis 5 kV Dauerbetriebsspannung (Effektivwert).

Die Dauerbetriebsspannung  $U_c$  muss so gewählt werden, dass einerseits im Betrieb kein zu hoher Strom fliesst, weil der Ableiter sonst thermisch zerstört würde, und andererseits bei Überspannungen die Begrenzung so früh wie möglich einsetzt.

Die Spannung  $U_c$  liegt deshalb deutlich unter der «Ansprechschwelle», das heisst unterhalb des Knies der Kennlinie,

das den Beginn des Durchbruchbereiches kennzeichnet. In diesem Bereich verhält sich der Ableiter kapazitiv. Bei Betriebsspannung beträgt die effektive Dauerfeldstärke am MO-Widerstand etwa 1,2 kV/cm. Der Übergang in den leitenden Bereich erfolgt beim 1,4fachen dieses Wertes.

Bild 6 demonstriert, dass erst beim Erreichen der Kennlinien-Kniespannung ein durch die Kennlinie geformter nichtsinusförmiger ohmscher Stromanteil fliesst.

Die bei der sogenannten Arbeitsprüfung eines MO-Ableiters verwendete überhöhte Wechselspannung  $U_r$  (Effektivwert) liegt meist beim 1,25fachen von  $U_c$  und darf bei der Typenprüfung nicht länger als 10 Sekunden anliegen. Länger

andauernde Belastungen oberhalb der Kniespannung können den Ableiter thermisch zerstören, falls die im Ableiter entstehende Wärme nicht mehr rasch genug nach aussen abgegeben werden kann.

Die thermische Stabilität eines Ableiters wird bei der sogenannten Arbeitsprüfung überprüft. Nach der Norm IEC 99.4 wird im Typenversuch, abhängig von der Ableiterklasse, die Energie entweder mit Hochstromstoss (Klasse 1) oder mit einer Anzahl Rechteck-Stossstromwellen (Klassen 2 bis 5) eingebracht. Dies ist bei der Dimensionierung eines MO-Ableiters zu berücksichtigen. Die Höhe der zulässigen betriebsfrequenten Überspannungen wird meistens auf die Betriebsspannung bezogen als sogenannte T-Kurve über der Belastungsdauer dargestellt und für jeden Ableitertyp angegeben.

Die Darstellung der Ableiterkennlinie nach Bild 5 illustriert hingegen das Verhalten bei Impulsüberspannungen. Deutlich ist zu erkennen, dass der Einfluss der verschiedenen Wellenformen auf die Restspannungen bei Strömen gleicher Grössenordnung nicht sehr gross ist. Während die Kennlinie im Schaltspannungsbereich sehr wenig ansteigt, ist im Bereich der sehr hohen Stossströme um 100 kA wieder ein deutlicher Anstieg der Kurve messbar. Die Beanspruchungen der Ableiter im Betrieb werden durch die standardisierten Stossstrom-Impuls-Wellenformen nachgebildet. Für diese Strom-Wellenformen sind die Restspannungen beim Stossstrom für 10 kA der Wellenform 8/20  $\mu$ s auf die Wechselspannung bezogen.

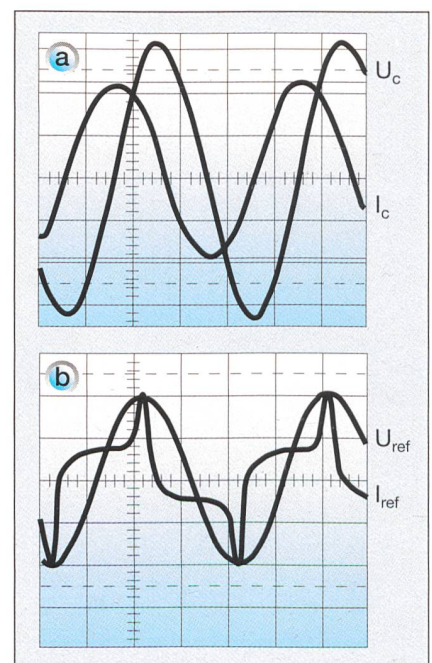


Bild 6 MO-Ableiter-Verhalten bei sinusförmiger Wechselspannung



		Mittelspannungsableiter							
		Hochspannungsableiter							
Nennableitstrom (Blitzstossstrom) BS	$I_n$ [kA]	5	10	10	10	10	20	20	40
Hochstossstrom HS	$I_{HC}$ [kA]	65	100	100	100	100	100	100	100
Rechteckstossstrom RW (2 ms) [A]		150	250	450	550	1000	1350	1800	2000
Leistungsentladungsklasse		1		2		3		4	
MO-Widerstand	$\varnothing$ [mm]	32	38	42	47	62	75	96	108
Energie bei RW und $U_c$	[kJ]	-2,5	-4,2	-5,5		-9	-13,3	-20	-30

Tabelle III Typische Daten von MO-Ableitern

Es ergeben sich beim physikalisch richtigen Bezug auf den Scheitelwert der zulässigen Dauerwechselspannung  $U_c$  für einen Mittelspannungsableiter der stärkeren Klasse 2 folgende Schutzverhältnisse:

- Steilimpulsstrom  $1/\mu s$  mit etwa  $20 \mu s$  bis zum Halbwert: Stromscheitelwerte 2,5 bis 5 kA. Schutz beim 1,8- bis 2,4fachen des  $U_c$ -Scheitels. Diese Wellenformen entstehen zum Beispiel beim Trennerschalten.
- Nennstossstrom  $8/20 \mu s$ : Stromscheitelwerte 2,5 bis 20 kA. Schutz beim 1,7- bis 2,2fachen des  $U_c$ -Scheitels. Diese Wellenform simuliert die am häufigsten auftretenden Blitzbeanspruchungen.
- Hochstossstrom  $4/10 \mu s$ : Stromscheitelwerte 30 bis 100 kA. Schutzbereich beim 2,3- bis 2,9fachen des  $U_c$ -Scheitels. Die Wellenform simuliert seltene steile und direkte Blitzeinschläge.
- Schaltstossstrom  $30/60 \mu s$ : Stromscheitelwerte 125 bis 3000 A. Schutzbereich beim 1,5- bis 1,8fachen des  $U_c$ -Scheitels. Die Welle simuliert Schaltvorgänge allgemeiner Art.

Diese Schutzbereiche sind ohne Einschränkung für Netze mit wirksamer Sternpunktterdung gültig. Für ein Netz mit isoliertem Sternpunkt oder Erdschlusskompensation sind die Werte etwa um das 1,4fache höher und daher etwas ungünstiger. Daten moderner Ableiter sind in Tabelle III zusammengestellt.

### Moderne MO-Ableiter-Konstruktionen

Während der Einführung der MO-Ableiter glichen die Ableiterkonstruktionen denen der älteren FS-Ableiter. Der Aktivteil der MO-Ableiter wurde in Porzellanisolatoren untergebracht und durch geeignete Abstandshalter im Inneren fixiert.

Abgesehen vom günstigeren Schutzverhalten wiesen diese Ableiter alle Nachteile der FS-Ableiter mit Porzellanisolation auf. Es sei hier nur erwähnt, dass diese Ableiter trotz Verwendung überprüfter Druckentlastungsvorrichtungen bei Überlastung gelegentlich explodierten.

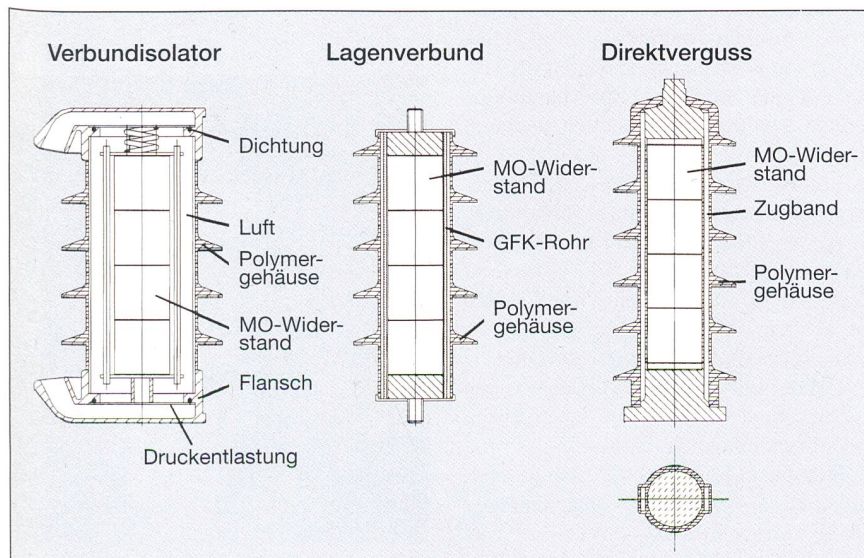


Bild 7 Moderne MO-Ableiter-Konstruktionen für Hoch- und Mittelspannung

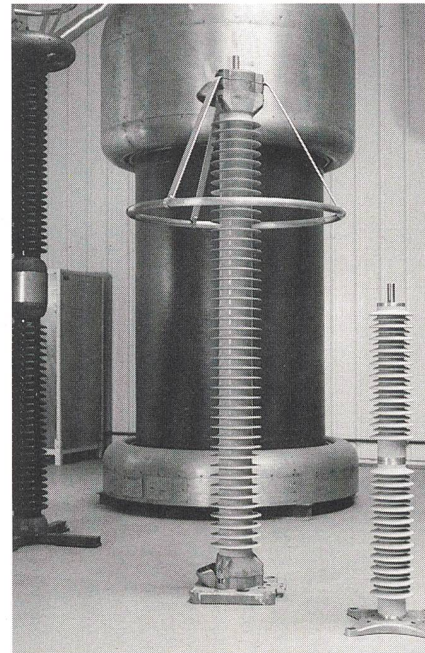


Bild 8 Hochspannungsableiter

Mitte GFK-Verbundisolator mit Silikonisolation  
rechts Integrierte Konstruktion mit Silikonverguss

Moderne Konstruktionen unter Verwendung von Polymermaterialien haben diesen und weitere Nachteile nicht mehr. Bild 7 gibt eine Übersicht der heute gebräuchlichen Basiskonstruktionen. Es sind dies die Ableiter mit folgenden Isolatorhüllen:

- Faserverstärkter (Gfk) Rohr-Verbundisolator mit äusserer Polymerisolation aus Silikonelast oder EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) (Bild 7 a). Der MO-Aktivteil befindet sich im Inneren eines Gfk-Rohres. Der äussere Isolator wird entweder direkt aufgegossen und chemisch mit dem Rohr verbunden oder aufgezogen und heiss aufgeschrumpft. Am Flansch des Rohres ist an beiden Seiten des Isolators eine dichte Druckentlastungsvorrichtung eingebaut, die bei Überlastung öffnet, um ein Bersten des Gfk-Rohres zu verhüten. Konstruktionen dieser Art können für Betriebsspannungen bis etwa 200 kV einteilig gebaut werden. Die Festigkeit des Gfk-Rohres erlaubt es, die gleichen mechanischen Daten (Biegefestigkeit) wie mit Porzellanen zu erreichen. Weil das Innere des Ableiters wie das der FS-Ableiter am MO-Aktivteil Luft enthält, ist auf strenge Teilentladungsfreiheit zu achten, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen. Bei sehr starker äusserer Verschmutzung des Isolators sind je nach Konstruktion innere Teilentladungen nicht gänzlich auszuschliessen.

Diese Ableiter haben sich bisher in über zehn Betriebsjahren bewährt und



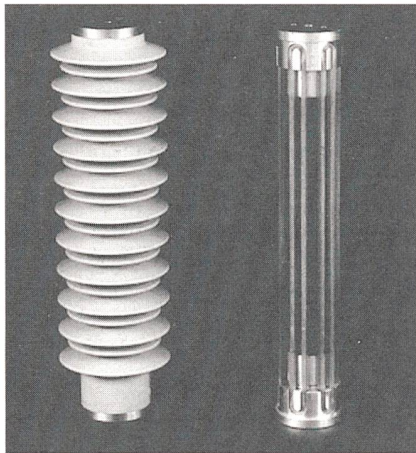


Bild 9 Silikonvergossene Integralkonstruktion  
rechts: unvergossener Aktivteil

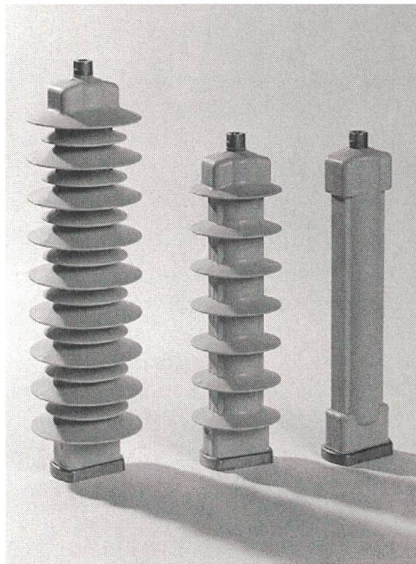


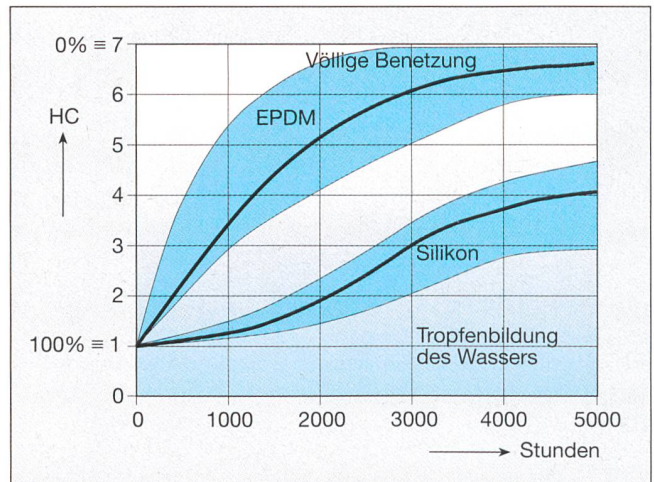
Bild 10 Überspannungsableiter mit Silikonisolation  
mit verlängertem und normalem Kriechweg sowie  
für Innenräume

sind auch in der Schweiz bis zu Betriebs-  
spannungen von 420 kV im Einsatz.

Bild 8 zeigt in der Mitte einen solchen  
Hochspannungsableiter vom Typ MKL  
mit Steuerring für 170-kV-Dauerbetriebs-  
spannung  $U_c$ .

- Faserverstärkter Rohrisolator mit Voll-  
verguss und äusserer Polymerisolation,  
vorzugsweise aus EPDM. (Bild 7 b). Der  
MO-Aktivteil befindet sich im Inneren  
eines Rohres, das zum Beispiel aus GfK  
gefertigt sein kann. Der Spalt zwischen  
dem Rohr und dem MO-Aktivteil wird  
anschliessend mit einer geeigneten Masse  
möglichst vollständig luftfrei vergossen.  
Die äussere Isolation wird von einem  
Überzugsisolator gebildet, oder dieser  
wird heiss aufgeschrumpft. Der Aufbau  
des Ableiters in verschiedenen konzentri-  
schen Schichten hat den Nachteil, dass  
Lufteinschlüsse nicht auszuschliessen

Bild 11 Hydrophobie  
(HC) von EPDM- und  
Silikon-Isolation während  
eines 5000-h-Alterungs-  
tests



sind. Konstruktionen dieser Art werden  
bei Spannungen von bis zu 72 kV einge-  
setzt. In Ausnahmefällen werden sie aber  
auch als Reihenparallelschaltungen für  
höhere Systemspannungen ausgelegt.

## Integralkonstruktion mit faserverstärkter Halterung und Vollverguss

Dieses robuste Konstruktionsprinzip  
(Bild 7 c) besteht aus zwei Elektroden,  
die miteinander durch zwei oder mehrere  
faserverstärkte Elemente verbunden sind.  
Es entsteht ein relativ steifer Käfig oder  
Rahmen. Im Inneren werden die MO-  
Widerstände angeordnet. Zusätzliche  
Metallzylinderstücke füllen den Innenteil  
völlig aus. Eine Druckschraube im Zen-  
trum einer der Elektroden wird von aus-  
sen mit einem definierten Drehmoment  
angezogen und in der Endstellung gesi-  
chert. Die Anordnung wird nach Einlegen  
in eine Form bei hoher Temperatur voll-  
ständig mit Silikon Gummi vergossen. Es  
entsteht ein monolithischer Block-Übers-  
pannungsableiter. Die Konstruktion mit  
ihren typischen Ausführungsmerkmalen  
wurde von ABB Schweiz patentiert. Sol-  
che Ableiter sind im Mittelspannungs-  
bereich seit über zehn Jahren weltweit  
erfolgreich im Einsatz.

Bild 9 zeigt einen nach dieser Technik  
aufgebauten Ableiter vom Typ Polim-H  
für  $U_c = 44$  kV vor und nach dem Vergie-  
ssen mit Silikon Gummi. Bild 10 enthält  
eine Auswahl nach diesem Grundprinzip  
aufgebauter Ableiter.

Die sehr flexible Bauweise gestattet es,  
im mehrteiligen Baukastenverfahren auch  
Hochspannungsableiter bis zu höchsten  
Systemspannungen aufzubauen.

Silikonkautschuk, auch Silikon Gummi,  
Silikonelast oder kurz Silikon genannt, ist  
ein hervorragendes Isoliermaterial. Ver-  
gleiche mit traditionellen Isolatoren wie  
Porzellan, Glas und auch anderen Kunst-

stoffen (z.B. EPDM) verdeutlichen die  
Überlegenheit des Silikons.

Wie bereits erwähnt, wird bei der vor-  
gestellten Integralkonstruktion die Sili-  
konisolerhülle durch Vergiessen oder  
Druckinjektion heiss haftend aufvulkani-  
siert. Durch verschiedene Formen kann  
dabei der Isolator der Struktur des MO-  
Ableiters optimal angepasst werden. Es  
entsteht ein luftspaltfreier Ableiterisola-  
tor mit folgenden vorteilhaften Eigen-  
schaften:

- Kein Kohlenwasserstoff in der chemi-  
schen Hauptbindung. Dies verhilft der  
Isolation zu einer ausgezeichneten Be-  
ständigkeit bei starker Oberflächenver-  
schmutzung und verhindert karboni-  
sierende Kriechspuren.
- Hydrophobie. Wasser benetzt die Iso-  
latoroberfläche nicht, sondern formt  
lediglich einzelne, isolierte Tropfen,  
die durch Schwerkraft und Wind von  
der Oberfläche abperlen.
- Schmutzablagerungen auf der Isolator-  
oberfläche werden durch die Diffusion  
von Molekülkomplexen aus der Sili-  
konisolation ebenfalls hydrophobiert,

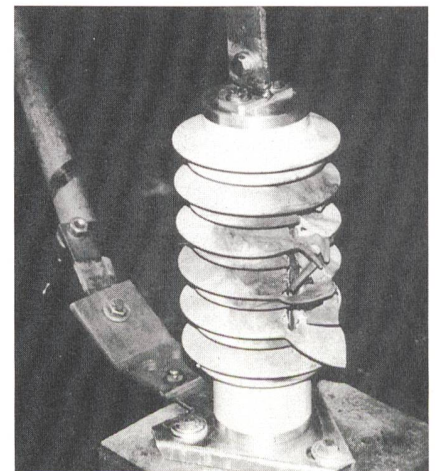


Bild 12 Überlastversuch an einem direktvergossen-  
en Ableiter mit Silikonisolation



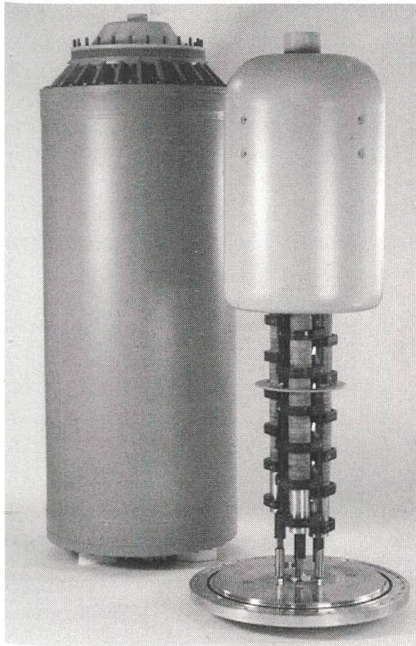


Bild 13 GIS-Überspannungsableiter mit  $U = 340$  kV  
links: kompletter Ableiter; rechts: Aktivteil mit Feldsteuerhaube

so dass trotz Oberflächenverschmutzung geringere Leckströme auftreten [3, 4].

- In Versuchen, wie dem 5000-h-Alterungstest nach IEC 1109, verringerte sich die Hydrophobie des Silikons um 50%, während sie bei EPDM gegen Versuchsende fast vollständig verlor (Bild 11). Ausserdem regenerierte sich das Silikon nach einigen Stunden Trockenzeit.
- Versuche mit Salzwassernebel nach IEC 507 zeigten, dass die Silikonisolation im Vergleich zu Porzellanisolatoren bei gleicher Salzverschmutzung im Mittel 30% kürzere Kriechwege benötigt [4].

Die vorgestellten modernen MO-Ableiter mit Kunststoffisolation der Typen MKL, MWK oder Polim werden deshalb ausschliesslich mit der hochwertigen Silikonisolation ausgeführt.

### Sicherheit bei Überlastung der Ableiter mit Silikonisolation

Bei Überlastung im Betrieb bildet sich im Ableiter ein Lichtbogen. Seit einigen Jahren wird verlangt, dass es unter diesen Verhältnissen nicht zu einer Explosion des Gehäuses kommen darf. Die Integralkonstruktion des Ableiters (Bild 7c) erfüllt diese Anforderung.

Das Ergebnis eines wirklichkeitsnahen Überlastungsversuchs ist in Bild 12 gezeigt. Erkennbar führte die Belastung zu einer Lichtbogeneinwirkung, ohne

allerdings eine Explosion des Ableiters zu verursachen [4].

### Überspannungsableiter für GIS-Anlagen

Die Ableiter für den direkten Einbau in gasisolierten Anlagen (GIS) mit  $\text{SF}_6$ -Isolation bestehen aus einer Reihenschaltung von MO-Widerstands-Stapeln in einer gasdichten Metallkapselung.

Eine gleichmässige Spannungsverteilung entlang des Ableiteraktivteils in der Metallumhüllung wird in axialer und radialer Richtung durch eine Kopfsteuerhaube auf der Hochspannungsseite erreicht. Die MO-Widerstände sind für Ableiter mit höheren Systemspannungen auf mehrere Säulen innerhalb der Metallumhüllung verteilt. Auf diese Weise kann die Baulänge des Ableiters erheblich verkleinert werden. Ein typischer Vertreter solcher Ableiter für eine 420-kV-Schaltanlage ist in Bild 13 zu sehen.

Es stehen für alle Anwendungen von 44 kV bis 800 kV und sogar darüber hinaus MO-Ableiter zur Verfügung. Ähnliche, teilweise gekapselte Ableiterbauformen werden auch bei modernen Mittelspannungsanlagen bis zu etwa 44-kV-Systemspannung mit genormten Konus-Steckanschlüssen verwendet.

### Ableiterkonstruktionen der Zukunft

#### Integration der Schutzfunktion

Die Weiterentwicklung der Ableitertechnik geht ohne Zweifel in Richtung einer stärkeren Integration der Schutzfunktion in Apparate und Baugruppen.

Eine erste Vorstellung dieser Art verdeutlicht Bild 14. Der Ableiter als Schutzelement ist so nahe wie möglich an die Transformatordurchführung heran gerückt. Natürlich ist dabei die Frage der optimalen Nähe durch Feldrechnungen sorgfältig zu klären, um mögliche negative gegenseitige Beeinflussungen auszuschliessen. Im illustrierten Fall zeigt sich, dass bis zu einem Mittelachsenabstand von 750 mm an der feingesteuerten Durchführung vom Ableiter keine wesentlichen Erhöhungen der Feldstärke im Vergleich zu einer entfernten Anordnung auftritt. Diese Integration ergibt ausser einer verbesserten Sicherheit gegen Bersten durch konsequenten Einsatz von Silikonisolatoren den Vorteil eines verbesserten Trafoschutzes.

Weitere Beispiele dieser Art bieten sich im Mittelspannungs-, aber auch im Hochspannungsbereich durch konsequente Integration der MO-Widerstände in Durchführungen, Kabelendverschlüsse und auch in das Innere von Transfor-

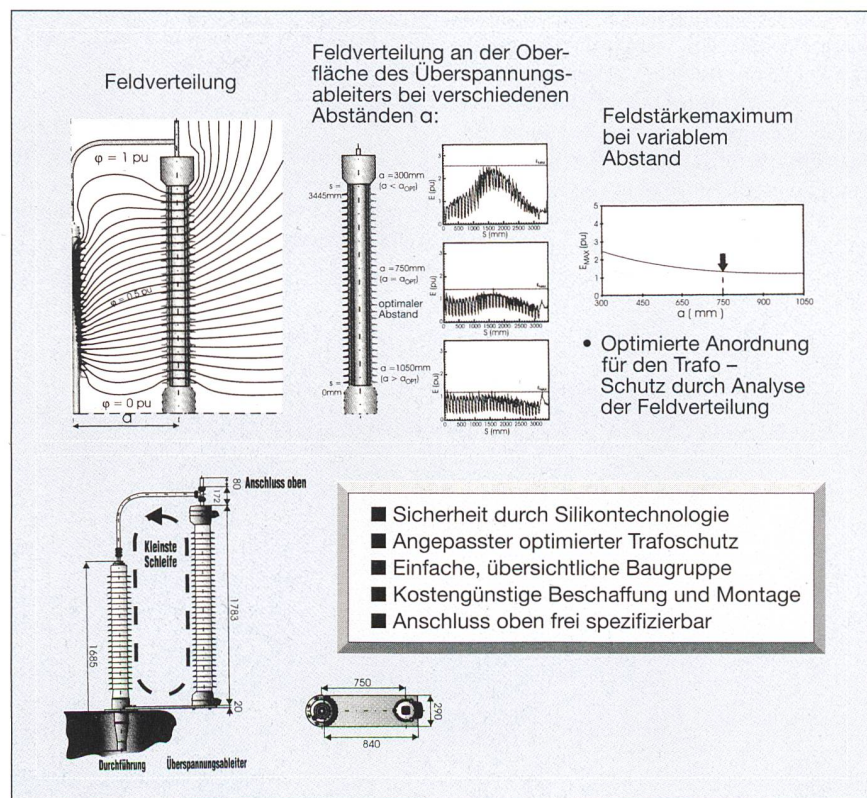


Bild 14 Durchführungsableitersystem

oben: Feldverteilung; unten: Vorteile der Lösung



Spannungsbeanspruchungsprobleme 1 und 2	1. ungleichförmige Feldbeanspruchung	2. transiente Überspannungen
Lösungen	1. Feldsteuerung	2. Überspannungsreduktion
Technische Möglichkeiten	1. Isolation mit nicht-linearer Impedanz	2. MO-Ableiter
Synergie	1. + 2. Dynamische Isolation mit integrierter MO-Funktion	

Tabelle IV Dynamische Isolation

maturen. Dahingehende Entwicklungen sind bereits angelaufen und zeichnen sich weltweit in verstärktem Masse ab.

## Die sich selbst schützende dynamische Isolation?

Es stellt sich die Frage, wie die Entwicklung weitergehen wird. Man könnte sich vorstellen, dass sie in Zukunft zu einer dynamischen, sich selbst schützenden Isolation führt.

Dazu sind in Tabelle IV die entsprechenden Vorstellungen verdeutlicht. Die heutige Isolation in der elektrischen Energietechnik wird durch ungleichmässige Feldbeanspruchung gekennzeichnet. Damit bei Beanspruchung durch transiente Überspannungen die Isolation der Beanspruchung standhält, ist einerseits durch Feldsteuerung die lokale Beanspruchung zu reduzieren, andererseits sind durch Ableiter die Überspannungen zu reduzieren. Der MO-Ableiter stellt je-

doch an und für sich einen Isolator mit nichtlinearer Impedanz dar. Heute schützt der Ableiter seine Umgebung. Es liegt nahe, die Isoliereigenschaft mit der Schutzzeigenschaft zu einer «dynamischen» Isolation zu verschmelzen. Das Ergebnis wäre eine interaktive Isolation, die sich selbst schützt. Auf diese Weise könnten die heute noch hohen Isolationspegel deutlicher reduziert und die Wirtschaftlichkeit und Systemzuverlässigkeit weiter verbessert werden.

Derzeit sind solche Isolationen noch im Stadium der Forschung, doch könnten hier die Zukunftsperspektiven eines wirkamen Überspannungsschutzes liegen.

## Literatur

- [1] F. Greuter, R. Perkins, M. Rosinelli, F. Schmückle: Der Metalloxid-Widerstand: Kernelement moderner Überspannungsableiter. ABB Technik (1989)1, S. 35 bis 42.
- [2] IEC Publication 994, 199 111: Metaloxide surge arresters without gaps for a.c. systems. Deutsche Fassung: DIN EN 60099/VDE 0675.
- [3] M. Kocher: Erfahrungen mit Silikonverbundisolatoren in den Tunneln der BLS Lötschbergbahn. Elektrische Bahnen 94(1996)11, S. 321-324.
- [4] W. Schmidt: Die neuen POLIM-Überspannungsableiter mit Silikonisolation für Mittelspannungsnetze. ABB Technik (1996)2.

## L'oxyde métallique – un parafoudre quasi-idéal

La tenue électrique des parafoudres à oxyde métallique répond de manière quasiment idéale aux exigences que l'on pose à un parafoudre. La caractéristique non linéaire de ces parafoudres céramiques repose sur leur structure granulaire microscopique. A chaque joint de grain à l'intérieur de la céramique d'oxyde métallique se forme une barrière de potentiel, qui ne peut être franchie qu'à partir de tensions de quelque 3,5 V. Le parafoudre ne devient conducteur et ne limite les surtensions produites que lorsqu'une telle tension est appliquée à tous les joints des grains.

Ces deux dernières décennies on a utilisé un nombre croissant de parafoudres à oxyde métallique. L'article explique les fondements physiques de ces parafoudres et en illustre le processus de fabrication. Puis sont présentées quelques formes constructives modernes à isolation polymère, qui permettent un fonctionnement à l'épreuve de l'explosion.